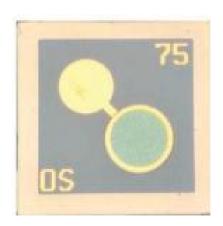


850nm 2.5Gbps GaAs PIN PD Chip φ75um



产品描述

850nm GaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 2.5Gbps; φ75um 有效面积; 850nm 高响应度; 顶照式平面结构

应用领域

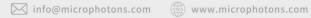
850nm AOC 接收器 | 1-5Gbps 光纤通道 | 多模光纤数据通信 | 短距离光纤网络

核心参数

无
无











详细参数

规格(Tc=25°C,单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ		850	860	nm	
响应度	R	0.55	0.6		A/W	λ=850nm
暗电流	I _D		0.05	0.3	nA	V _R =-5V
电容	С		0.3	0.4	pF	V _R =-2V,f=1MHz
带宽	Bw		6.0		GHz	V _R =-2V
113.95	DW.		0.0			3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		75		um	
通道之间的中心			250*250*150		11172	L*W*H
间距(pitch)			230230120		um	L.M.L